

БКО.347.222-02 ТУ

**573РФ2**

## 16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

НМОП технология

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность длительного хранения информации при включенном и отключенном питании и многократной смены информации.

Предназначено для работы в блоках памяти специализированных электронно-вычислительных машин, в устройствах сбора и обработки информации, устройствах информатики и контроля.

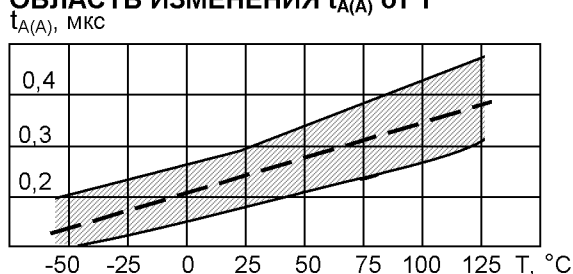
- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания  $5В \pm 10\%$ ;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования  $24,5В \pm 0,5В$ ;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.



### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч	$t_{и}$	100 000
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	25

### ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ ОТ Т



### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1-8, 19, 22, 23	A1-A11	Вход адресный
9 -11, 13 -17	D1-D8	Вход-выход
12	OV	Общий
18	$\overline{CE}$	Вход сигнала разрешения обращения
20	$\overline{OE}$	Вход сигнала разрешения выхода
21	WR/RD	Вход сигнала записи-считывания
24	$U_{CC}$	Источник питания

### ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ

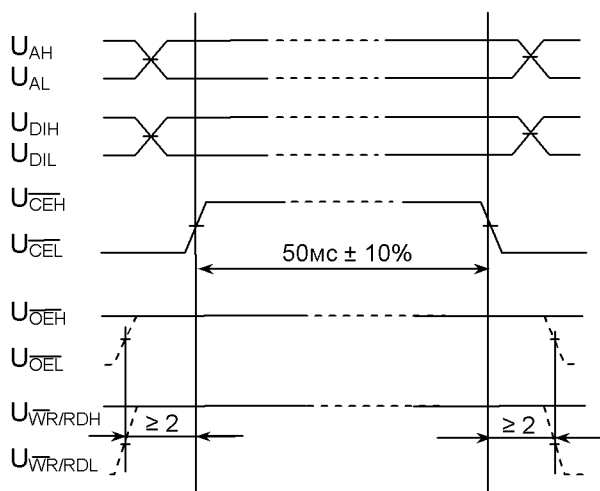
Механические удары, g	1500
Линейное ускорение, g	20 000
Вибрация 1 - 5 000 Гц, g	40
Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси	1:1

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до 85
Изменение температуры среды, °С	от - 60 до 125
Повышенная влажность при Т = 35 °С, %	до 98
Температура пайки, °С	235 ± 5
Продолжительность, с	2 ± 0,5

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ( $U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ )

Символ	Параметр	T, °C	573PФ2
$U_{DOL}$	Напряжение выхода низкого уровня, В ( $I_{OL} = 2,1 \text{ мА}$ )	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
$U_{DOH}$	Напряжение выхода высокого уровня, В ( $I_{OH} = 0,4 \text{ мА}$ )	от - 60 до 85	$\geq 2,4$
$I_{CC}$	Ток потребления в режиме считывания, мА	25, 85 - 60	$\leq 80$ $\leq 110$
$I_{WR/RD}$	Ток сигнала записи-считывания, мА	25, 85 - 60	$\leq 6$ $\leq 10$
$I_{CCS}$	Ток потребления в режиме хранения, мА	25, 85 - 60	$\leq 21$ $\leq 35$
$I_{WR/RDS}$	Ток сигнала записи-считывания в режиме хранения, мА	от - 60 до 85	$\leq 2$
$I_{LI}$	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 60 до 85	$\leq 10$
$t_{A(A)}$	Время выборки адреса, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,45$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 60 до 85	$\leq 0,25$
$t_{SG1}$	Время хранения информации при отключённом питании, ч	85 от - 60 до 25	$\geq 25 \text{ 000}$ $\leq 100 \text{ 000}$
$t_{SG2}$	Время хранения информации при включённом питании, ч	от - 60 до 85	$\geq 25 \text{ 000}$
$C_I$	Входная ёмкость вывода вход-выход, пФ	от - 60 до 85	$\leq 12$
$N_{CY}$	Количество циклов перепрограммирования, цикл	$25 \pm 10$	$\geq 100$

**ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ**


Тепловое сопротивление кристалл - корпус  $0,05^\circ\text{C}/\text{мВт}$ .

Предельное значение температуры перехода (кристалла)  $130^\circ\text{C}$  при  $T_{\text{окр.ср.}} = 85^\circ\text{C}$ .

Время стирания информации, с.

$$t_{EE} = \frac{H_E}{E_E}, \quad \text{где}$$

$E_E$  – измеренное значение энергетической освещённости в плоскости окна корпуса,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ ;  
 $H_E = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$  – требуемое значение энергетической экспозиции для стирания информации в микросхеме.

Стирание информации проводят путём воздействия ультрафиолетового излучения с длиной волны  $253,7 \text{ нм}$ ;

Возможна запись информации серией импульсов последовательно по одному импульсу в каждый адрес.